PCT

世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 B41J 2/16, 2/045, 2/055

(11) 国際公開番号 **A1**

WO98/46431

(43) 国際公開日

1998年10月22日(22.10.98)

(21) 国際出願番号

PCT/JP98/01678

JP

(22) 国際出願日

1998年4月10日(10.04.98)

(30) 優先権データ

特願平9/97780

1997年4月15日(15.04.97)

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について)

セイコーエプソン株式会社

(SEIKO EPSON CORPORATION)[JP/JP]

〒163-0811 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

西川尚男(NISHIKAWA, Takao)[JP/JP] /

高桑敦司(TAKAKUWA, Atsushi)[JP/JP] 人 〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号

セイコーエプソン株式会社内 Nagano, (JP)

(74) 代理人

弁理士 鈴木喜三郎、外(SUZUKI, Kisaburo et al.)

〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号

セイコーエプソン株式会社 知的財産部内 Nagano, (JP)

CN, KR, SG, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, (81) 指定国 DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開書類

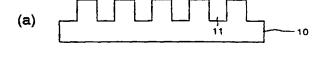
国際調査報告書

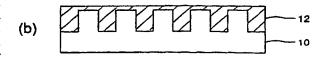
INK JET PRINTER HEAD AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME (54)Title:

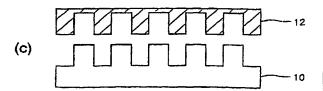
(54)発明の名称 インクジェットプリンタヘッドおよびその製造方法

(57) Abstract

A method for manufacturing an ink jet printer head which can cope with the tendency toward resolution improvement at a low cost through simple steps. Specifically, a method for manufacturing an ink jet printer head which jets ink by pressurizing an ink pressurizing-chamber by means of a piezoelectric element that is provided on a head base forming the ink pressurizing chamber and deformed by an electric signal, wherein a method for manufacturing the head base comprises the first step of manufacturing a master disk (10) having an uneven pattern corresponding to that of the head base, the second step of forming the head base (12) by applying and solidifying a head base forming material to and on the surface of the master disk (10) carrying the uneven pattern, the step of releasing the head base (12) from the master disk (10), and the fourth step of forming ink jet nozzle openings (13) in the head base (12).









安価で高解像度化に対応可能なインクジェットヘッドを、簡単な工程により製 造できるようにするため、インク圧力室を形成するヘッド基台上に設けられた、 電気信号により変形する圧電素子により、前記インク圧力室を加圧してインクを 吐出するインクジェットプリンタヘッドの製造方法において、前記ヘッド基台の 製造工程は、前記ヘッド基台に応じた所定の凹凸パターンを有する原盤 (10) を製造する第1工程と、前記原盤の凹凸パターンを有する表面上に前記ヘッド基 台形成用材料を塗布、固化させることにより前記ヘッド基台(1.2)を形成する 第2工程と、前記ヘッド基台(12)を前記原盤(10)から剥離する第3工程 と、前記ヘッド基台(12)上にインク吐出用ノズル口(13)を形成する第4 工程と、を有することとした。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

アルメニア アルメニア オーストリア オーストラリア アゼルバイジャン ボズニア・ヘルツェゴビナ AM AT AU AZ B A B B バルバドス ベルギー BE BF BG ブルギナ・ファン ブルガリア フルガリア ベナシンル ベラシル カナダ 中コンプ B Ř B Y ĈĀ CG CH CI CM スイス コートジボアール カメルーン CN 中国 中キナデエスペークア ション・アンスペークアンスペークアンスペークア CCCDE

フィンランド フランス ガボン FR GA GB ぞ国 グレ GE GH GM デンビア ギニア GW GR ギリシテナ クロアチリー HR ΙD IL IS IT JP ケニア キルギスタン KG KP KZ LI **韓国** カザフスタン

スァンペッシア セントルシア リヒテンシュタイン スリ・ランカ

リレリルラモモマッペソトアとヴェア アプア アプア アカアドガドアカトナルガドガドル ルルロー LS L V MC MG マケドニア旧ユーゴスラヴィア 共和国 MN MR MW モーリタニア マラウイ メキシコ ニジェール オランダ NE ールウェ ュー・ジ ーランド NO ポルトカル

スーダン スウェーデン シンガポール スロヴェニア

スロワテキア シエラ・レ オワジランド スティゴー トーゴー SL SZ タジキスタン TM TR TT UA UZ

45

WO 98/46431 PCT/JP98/01678

明細書

インクジェットプリンタヘッドおよびその製造方法

技術分野

本発明は、インク吐出の駆動源に圧電体素子を使用するインクジェットプリンタヘッドおよびその製造方法に関する。

背景技術

液体あるいはインク吐出の駆動源である電気ー機械変換素子として、PZTからなる圧電素子を使用した圧電タイプのインクジェットプリンタヘッドが存在する。

図11は、このタイプのインクジェットプリンタヘッドの構造の一例を示した図である。12はヘッド基台、29は共通電極(振動板)、32は圧電素子、33はインク圧力室、35はインク吐出用ノズル口13を有するノズルプレート、36はインク供給口、37はリザーバ、38はインクタンク口であり、この他に図示されていない配線パターン、信号回路、インクタンク等から構成される。

このようなインクジェットプリンタヘッドは、一般にリソグラフィ技術を応用した工程によって製造されている。図12は、その製造工程の一例を簡単に示す図であり、図11におけるA-A'の断面図で示されている。

まず、図12(a)に示すように、表面に熱酸化膜40を形成したシリコン基板(ウエハ)39上に、共通電極29、圧電体薄膜30、上電極31を順次形成する。

次いで、図12(b)に示すように、上電極31上にレジスト層15を形成し、 マスクを介して所定のパターンに露光、現像して、レジスト層15をパターンニ ングする。

そして、図12(c)に示すように、レジスト層15をマスクとして圧電体薄膜30および上電極31をエッチングした後、レジスト層15を剥離して、圧電素子32を得る。

次に、図12(d)に示すように、圧電素子32を形成した反対側の面に、レジスト層15を形成し、マスクを介して所定のパターンに露光、現像して、レジスト層15をパターンニングする。

そして、このレジスト層15をマスクとして酸化膜40およびシリコンウエハ 39をエッチングした後、レジスト層15を剥離して、図12(e)に示すよう に、インク圧力室33等が形成されたヘッド基台12を得る。

こうして製造されたヘッド基台12に、図12(f)に示すように、インク圧力室33に対応した位置にインク吐出用ノズルロ13が形成されたノズルプレート35を接着層を介する等して接合(接着)し、さらに、配線パターン、信号回路、インクタンク等を形成してインクジェットプリンタヘッドを得る。

発明の開示

近年、パーソナルコンピュータの発達に伴い、インクジェットプリンタが急速 に普及しつつある。今後、インクジェットプリンタのさらなる普及のためには、 低コスト化および高解像度化が必要であり、それを実現するためは、インクジェ ットプリンタヘッドの低コスト化および高解像度化は必要不可避の課題である。

しかしながら、前述の従来技術では、ヘッド基台の製造に非常に多くの工程を 必要とし、飛躍的な低コスト化は容易ではない。

また、高解像度化に伴い、インク圧力室の幅および高さ、インク圧力室を仕切る隔壁の幅(図12において、それぞれW、H、W'で示されている)を小さくする必要がある。

しかし、前述の従来技術では、インク圧力室の高さは、使用するシリコンウエハの厚さとほぼ同じである。したがって、インク圧力室の高さを低くするには、さらに薄いシリコンウエハを使用しなければならない。ところが、現状でも約200μmの厚さのものを用いており、これよりさらに薄いシリコンウエハの使用は、強度等の点でプロセス流動の際のハンドリングが困難となる。

さらには、前述の従来技術では、ヘッド基台とノズルプレートを接着剤を用いて一体化させており、高解像度化によってインク圧力室に接着剤がはみ出さないようにするのが困難となる。

そこで、本発明はこのような問題点を解決するもので、その目的とするところは、安価で高解像度化に対応可能なインクジェットヘッドを、簡単な工程により 製造することが可能なインクジェットヘッドの製造方法を提供するところにある。

本発明に係るインクジェットへッドの製造方法は、インク圧力室を形成するへッド基台上に設けられた電気信号により変形する圧電素子により、前記インク圧力室を加圧してインクを吐出するインクジェットプリンタへッドの製造方法において、前記へッド基台の製造工程は、前記へッド基台に応じた所定の凹凸パターンを有する原盤を製造する第1工程と、前記原盤の凹凸パターンを有する表面上に前記へッド基台形成用材料を塗布、固化させることにより前記へッド基台を形成する第2工程と、前記へッド基台を前記原盤から剥離する第3工程と、前記へッド基台上にインク吐出用ノズルロを形成する第4工程と、を含むことを特徴とする。この特徴により、インク吐出用ノズルー体型のインクジェットプリンタへッドを簡単な工程により製造できるため、安価で高解像度に対応できるインクジェットプリンタへッドを提供することができる。

本発明は、要するに、原盤を型としてヘッド基台を転写形成する方法である。 前記原盤は、一旦製造すればその後、耐久性の許す限り何度でも使用できるため、 2個目以降のヘッド基台の製造工程において省略でき、工程数の減少および低コ スト化を図ることができる。

また、ノズルプレートが一体形成されるため、高解像度化が容易となる。 第1工程として、具体的には例えば次の方法がある。

(1)原盤母材上に所定のパターンに応じたレジスト層を形成し、次いで、エッチングによって前記原盤母材上に前記凹凸パターンを形成して前記原盤を製造する工程。

この工程によれば、エッチング条件を変えることにより、凹凸パターンの形状 を高精度かつ自由に制御することが可能である。

前記原盤母材としては、シリコンウエハが好適である。シリコンウエハをエッチングする技術は、半導体デバイスの製造技術として用いられており、高精度の加工が可能である。

また、前記原盤母材としては、石英ガラスも好適である。石英ガラスは、機械

的強度、耐熱性、耐薬品性等に優れ、さらには後述する、原盤とヘッド基台界面 に照射光を照射して剥離性を向上させる手段において好適に用いられる短波長領 域の光に対する透過性に優れる。

(2)第2の原盤上に所定のパターンに応じたレジスト層を形成し、次いで、前記第2の原盤およびレジスト層を導体化し、さらに電気メッキ法により金属を電着させて金属層を形成した後、この金属層を前記第2の原盤およびレジスト層から剥離して前記原盤を製造する工程。

この工程のより得られた金属製原盤は、一般に耐久性および剥離性に優れる。 次に、前記ヘッド基台形成用材料は、エネルギーの付与により硬化可能な物質 であることが好ましい。

このような物質を利用すると、原盤上に塗布する際には低粘性の液状の物質として取り扱うことができるため、原盤上の凹部の微細部にまでヘッド基台形成用材料を容易に充填することが可能となり、したがって、原盤上の凹凸パターンを精密に転写することが可能となる。

エネルギーとしては、光、熱、あるいは光および熱の双方のいずれかであることが好ましい。こうすることで、汎用の露光装置やベイク炉、ホットプレートが利用でき、低設備コスト化、省スペース化を図ることができる。

また、前記ヘッド基台は、要求される機械的強度、耐食性、耐熱性等の物性を満足し、かつ、原盤上の凹部の微細部にまで容易に充填することが可能であれば、熱可塑性の物質により形成してもよい。

このような物質としては、具体的には例えば、水和ガラスが好適である。

水和ガラスは、低温で可塑性を示すガラス材料であり、成形後に脱水処理を施すことにより機械的強度、耐食性、耐熱性に優れたヘッド基台が得られる。

また、第3工程では、原盤とヘッド基台の材質の組み合わせによっては、密着性が高くなってしまい、原盤からヘッド基台を剥離することが困難となる場合がある。このような場合、以下にあげるいずれかの方法、あるいは、2方法以上を併用することで、原盤からの型抜きを良好に行うことができる。

(3)前記原盤上に形成される凹凸パターンの凹部形状を、開口部が低部より大きいテーパ形状とする方法。

- (4)前記凹凸パターンを有する原盤表面に、前記ヘッド基台との密着性の低い材質からなる離型層を形成する方法。
 - (5) 前記原盤とヘッド基台の界面に照射光を照射する方法。

この場合、照射光の照射により内部および/または前記原盤との界面において 剥離を生じせしめる分離層を、原盤とヘッド基台との間に設けてもよい。こうす ることで、ヘッド基台に直接ダメージを与えることがなく、また、ヘッド基台形 成用材料の選択の自由度も増す。

次に、第4工程としては、具体的には例えば次の方法がある。

- (6) リソグラフィ法により前記インク吐出用ノズル口を形成する方法。
- (7)レーザ光により前記インク吐出用ノズル口を形成する方法。
- (8) 収束イオンビームにより前記インク吐出用ノズル口を形成する方法。
- (9) 放電加工により前記インク吐出用ノズル口を形成する方法。

さらに、本発明は上記各工程によって製造されたインクジェットプリンタへッドであることを特徴とする。

図面の簡単な説明

図1は、本発明の実施形態におけるヘッド基台を製造する工程を示す図である。 図2は、本発明の第1工程の第1の実施形態における原盤を製造する工程を示す図である。

図3は、本発明の第1工程の第2の実施形態における原盤を製造する工程を示す図である。

図4は、本発明の第1工程の第2の実施形態における原盤を製造する工程を示す図である。

図5は、本発明の実施形態における原盤を示す図である。

符号の説明

- 図6は、本発明の実施形態における離型層が形成された原盤を示す図である
- 図7は、本発明の実施形態における照射光を照射する工程を説明する図である。
- 図8は、本発明の実施形態における照射光を照射する工程を説明する図である。
- 図9は、本発明の実施形態におけるインク吐出用ノズル口を形成する工程を示

す図である。

図10は、本発明の実施形態におけるヘッド基台上に圧電素子を形成する工程を示す図である。

図11は、インクジェットプリンタヘッドの構造の一例を示す図である。

図12は、インクジェットプリンタヘッドの従来の製造工程の一例を示す図である。

- 10 原盤
- 11 凹部
- 12 ヘッド基台
- 13 インク吐出用ノズルロ
- 14 原盤母材
- 15 レジスト層
- 16 マスク
- 17 光
- 18 露光領域
- 19 エッチャント
- 20 第2の原盤
- 21 マスク
- 22 導体化層
- 23 金属層
- 24 離型層
- 25 照射光
- 26 分離層
- 27 マスク
- 28 第3の原盤
- 29 共通電極
- 30 圧電体薄膜
 - 31 上電極

7

- 32 圧電素子
- 33 インク圧力室
- 34 接着層
- 35 ノズルプレート
- 36 インク供給口
- 37 リザーバ
- 38 インクタンクロ
- 39 シリコン基板 (ウエハ)
- 40 熱酸化膜

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の好適な実施の形態について図面を参照にして説明する。

図1は、本発明の実施形態におけるヘッド基台を製造する工程を示す図である。本発明のヘッド基台の製造方法は、図1(a)に示すように、製造しようとするヘッド基台に応じた凹凸パターンを有する原盤10を製造する第1工程と、図1(b)に示すように、原盤10の凹凸パターンを有する表面上にヘッド基台形成用材料を塗布、固化させることによりヘッド基台12を形成する第2工程と、図1(c)に示すように、このヘッド基台12を原盤10から剥離する第3工程と、図1(d)に示すように、ヘッド基台12上にインク吐出用ノズル口13を形成する第4工程と、からなる。

以下、各工程について詳述する。

(第1工程)

製造しようとするヘッド基台に応じた凹凸パターンを有する原盤10を製造する工程である。

図2は、第1工程の第1の実施形態における原盤を製造する工程を示す図である。

具体的には、以下の方法により行う。

まず、図2(a)に示すように、原盤母材14上にレジスト層15を形成する。 原盤母材14は、表面をエッチングして原盤とするためのもので、ここではシ リコンウエハが用いられる。シリコンウエハをエッチングする技術は、半導体デバイスの製造技術において確立されており、高精度なエッチングが可能である。なお、原盤母材 1 4 は、エッチング可能な材料であれば、シリコンウエハに限定されるものではなく、例えば、ガラス、石英、樹脂、金属、セラミックなどの基板あるいはフィルム等が利用できる。

レジスト層 1 5 を形成する物質としては、例えば、半導体デバイス製造において一般に用いられている、クレゾールノボラック系樹脂に感光剤としてジアゾナフトキノン誘導体を配合した市販のポジ型のレジストをそのまま利用できる。ここで、ポジ型のレジストとは、露光された領域が現像液により選択的に除去可能となるレジストのことである。

レジスト層15を形成する方法としては、スピンコート法、ディッピング法、 スプレーコート法、ロールコート法、バーコート法等の方法を用いることが可能 である。

次に、図2(b)に示したように、マスク16をレジスト層15の上に配置し、マスク16を介してレジスト層15の所定領域のみに光17を照射して、露光領域18を形成する。

マスク16は、図2(e)に示す凹部11に対応した領域においてのみ、光17が透過するようにパターン形成されたものである。

また、凹部 1 1 は製造しようとするインクジェットヘッドのインク圧力室、インク供給口、リザーバ等を形成する隔壁の形状および配列に応じて形成される。

そして、レジスト層15を露光した後、所定の条件で現像処理を行うと、図2 (c)に示すように、露光領域18のレジストのみが選択的に除去されて原盤母材14が露出し、それ以外の領域はレジスト層15により覆われたままの状態となる。

こうしてレジスト層 1 5 がパターニングされると、図 2 (d) に示すように、 このレジスト層 1 5 をマスクとして原盤母材 1 4 を所定の深さエッチングする。

エッチングの方法としてはウエット方式またはドライ方式があるが、原盤母材 14の材質、エッチング断面形状やエッチングレート等の諸特性において要求さ れる仕様に応じて適宜選択される。制御性の点からいうとドライ方式の方が優れ ており、エッチングガス種、ガス流量、ガス圧、バイアス電圧等の条件を変更することにより、凹部11を矩形に加工したり、テーパーを付けたりと、所望の形状にエッチングすることができる。とりわけ、誘導結合型(ICP)方式、エレクトロンサイクロトロン共鳴(ECR)方式、ヘリコン波励起方式等の高密度プラズマのエッチング方式は、原盤母材14を深くエッチングするのに好適である。次に、エッチング完了後に、図2(e)に示すように、レジスト層15を除去して、ヘッド基台に応じた凹凸パターンを有する原盤10とする。

上記実施形態では、原盤母材上に凹凸パターンを形成するに際し、ポジ型のレジストを用いたが、露光領域が現像液に対して不溶化し、未露光領域が現像液により選択的に除去可能となるネガ型のレジストを用いても良く、この場合には、上記マスク16とはパターンが反転したマスクが用いられる。あるいは、マスクを使用せずに、レーザ光あるいは電子線によって直接レジストをパターン状に露光しても良い。

次に、第1工程の第2の実施形態について説明する。

図3および図4は、第1工程の第2の実施形態における原盤を製造する工程を示す図である。

具体的には、以下の方法により行う。

まず、図3(a)に示すように、第2の原盤20上にレジスト層15を形成する。

第2の原盤20は、プロセス流動におけるレジスト層15の支持体としての役目を担うものであり、プロセス流動に必要な機械的強度や薬液耐性等のプロセス耐性を有し、レジスト層15を形成する物質とのぬれ性、密着性が良好なものであれば特に限定されるものではなく、例えば、ガラス、石英、シリコンウエハ、樹脂、金属、セラミックなどの基板が利用できる。ここでは、表面を酸化セリウム系の研磨剤を用いて平坦に研磨した後、洗浄、乾燥したガラス製原盤を用いる。

また、レジスト層15を形成する物質および方法としては、上記第1の実施形態において説明した物質および方法と同一のものが利用できるため説明を省略する。

次に、図3(b)に示したように、マスク21をレジスト層15の上に配置し、

マスク21を介してレジスト層15の所定領域のみに光17を照射して、露光領域18を形成する。

マスク21は、製造しようとする原盤10の凸部に相当する領域においてのみ、 光17が透過するようにパターン形成されたもので、図2のマスク16とパターンが反転した関係にある。

そして、レジスト層15を露光した後、所定の条件で現像処理を行うと、図3 (c)に示すように、露光領域18のレジストのみが選択的に除去されて、レジスト層15がパターニングされる。

そして次に、図4(a)に示すように、レジスト層15および第2の原盤20 上に導体化層22を形成して表面を導体化する。

導体化層22としては、例えば、Niを500Å~1000Åの厚みで形成すればよい。導体化層22の形成方法としては、スパッタリング、CVD、蒸着、無電解メッキ法等の方法を用いることが可能である。

そしてさらに、この導体化層22により導体化されたレジスト層15および第2の原盤20を陰極とし、チップ状あるいはボール状のNiを陽極として、電気メッキ法によりさらにNiを電着させて、図4(b)に示すように金属層23を形成する。

電気メッキ液の組成の一例を以下に示す。

スルファミン酸ニッケル:500g/1

ホウ酸 : 30g/l

塩化ニッケル : 5g/1

レベリング剤 : 15 mg/l

次いで、図4 (c)に示すように、導体化層22および金属層23を第2の原盤20から剥離した後、必要に応じて洗浄して、これを原盤10とする。

なお、導体化層22は、必要に応じて剥離処理を施すことにより金属層23から除去してもよい。

また、第2の原盤20は、耐久性の許す限り、再生、洗浄処理を施すことにより再利用可能である。

上記第2の実施形態においても上記第1の実施形態同様、ネガ型のレジストを

用いても良く、この場合には、上記マスク21、すなわち、図2のマスク16と同様のパターンを有するマスクが用いられる。あるいは、マスクを使用せずに、レーザ光あるいは電子線によって直接レジストをパターン状に露光しても良い。 (第2工程)

第1工程において製造した原盤10の凹凸パターンを有する表面上に、ヘッド 基台形成用材料を塗布、固化させることによりヘッド基台12を形成する工程で ある。

ヘッド基台形成用材料としては、インクジェットヘッドのヘッド基台として要求される機械的強度や耐食性等の特性を満足するものであり、かつ、プロセス耐性を有するものでれば特に限定されるものではなく、種々の物質が利用できるが、エネルギーの付与により硬化可能な物質であることが好ましい。

このような物質を利用すると、原盤上に塗布する際には低粘性の液状の物質として取り扱うことができる。そのため、原盤上の凹部の微細部にまでヘッド基台 形成用材料を容易に充填することが可能となり、したがって、原盤上の凹凸パタ ーンを精密に転写することが可能となる。

エネルギーとしては、光、熱、あるいは光および熱の双方のいずれかであることが好ましい。こうすることで、汎用の露光装置やベイク炉、ホットプレートが利用でき、低設備コスト化、省スペース化を図ることができる。

このような物質としては、具体的に例えば、アクリル系樹脂、エポキシ系樹脂、 メラミン系樹脂、ノボラック系樹脂、スチレン系樹脂、ポリイミド系等の合成樹脂、ポリシラザン等のケイ素系ポリマが利用できる。

このようなヘッド基台形成用材料を原盤10上に塗布する。

ヘッド基台形成用材料を塗布する方法としては、スピンコート法、ディッピン グ法、スプレーコート法、ロールコート法、バーコート法等が利用できる。

ヘッド基台形成用材料に溶剤成分を含むものは、熱処理を行って溶剤を除去する。

そして、ヘッド基台形成用材料に応じた硬化処理を施すことにより、固化させてヘッド基台12を形成する。

また、ヘッド基台形成用材料として熱可塑性の物質を利用してもよい。このよ

うな物質としては、水和ガラスが好適である。水和ガラスとは、数~数十wt%の水を含有した常温で固体のガラスであり、低温(組成によっては100℃以下)で可塑性を示す。この水和ガラスをヘッド基台に成形後に、脱水処理を施すと機械的強度、耐食性、耐熱性に優れたヘッド基台が得られる。

(第3工程)

第2工程において原盤10上に形成したヘッド基台12を、原盤10から剥離 する工程である。

剥離方法としては、具体的に例えば、ヘッド基台12が形成された原盤10を 固定し、ヘッド基台12を吸着保持して機械的に引き剥がす。

剥離に際し、原盤10とヘッド基台12の材質の組み合わせによっては密着性 が高くなり、原盤10からヘッド基台12を剥離することが困難となる場合があ る。

このような場合、例えば図5に示すように、原盤10上に形成される凹凸パターンの凹部形状を、開口部が低部より大きいテーパ形状とすることが好ましい。こうすることで、剥離の際に原盤10とヘッド基台12との間に働く摩擦力等の応力を低減できるため、原盤10からの型抜きを良好に行うことができる。

また、図6に示すように、原盤10の凹凸パターンを有する表面上に、ヘッド基台12との密着性の低い材質からなる離型層24を形成しても同様の効果が得られる。離型層24としては、原盤10およびヘッド基台12の材質に合わせて適宜選択すればよい。

また、図7に示すように、剥離する前に、原盤10とヘッド基台12の界面に 照射光25を照射して、原盤10とヘッド基台12との密着力を低減または消失 させて、原盤10からの型抜きを良好に行えるようにしてもよい。この方法は、 照射光25により原盤10とヘッド基台12の界面において、原子間または分子 間の種々の結合力を低減または消失させること、実際には、アブレーション等の 現象を発生させて界面剥離に至らしめるものである。

さらには、照射光25によりヘッド基台12から気体が放出され、分離効果が 発現される場合もある。すなわち、ヘッド基台12に含有されていた成分が気化 して放出されて分離に寄与する。 の光(放射線)が利用可能である。

照射光25としては、例えば、エキシマレーザ光が好ましい。エキシマレーザは、短波長領域で高エネルギーを出力する装置が実用化されており、極めて短時間の処理が可能となる。よって、界面近傍においてのみアブレーションが引き起こされ、原盤10およびヘッド基台12に温度衝撃をほとんど与えることがない。なお、照射光25としては、原盤10とヘッド基台12の界面において界面剥離を起こさせるものであればエキシマレーザ光に限定されるものではなく、種々

この場合、原盤10は照射光25に対して透過性を有することが必要である。 透過率は10%以上であることが好ましくは、さらに好ましくは50%以上であ る。透過率が低すぎると、照射光の原盤透過時の減衰が大きくなり、アブレーション等の現象を起こすのに要する光量が大きくなる。石英ガラスは、短波長領域 の透過率が高く、機械的強度や耐熱性においても優れているため、原盤材料とし て好適である。

また、図8に示すように、照射光25により原盤10との界面において剥離を生じせしめる分離層26を原盤10とヘッド基台12との間に設けてもよい。分離層26内および/または界面においてアブレーション剥離が起こるようにすることで、原盤10およびヘッド基台12に直接衝撃を与えることがない。

分離層26としては、具体的には例えば、非晶質シリコン、酸化ケイ素、ケイ酸化合物、酸化チタン、チタン酸化合物、酸化ジルコニウム、ジルコン酸化合物、酸化ランタン、ランタン酸化合物などの各種酸化物セラミックス、(強)誘電体あるいは半導体、窒化ケイ素、窒化アルミニウム、窒化チタン等の窒化セラミックス、アクリル系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリアミド、ポリイミド等の有機高分子材料、A1、Li、Ti、Mn、In、Sn、Y、La、Ce、Nd、Pr、Gd、Smの中から選ばれた1種または2種以上の合金、等が利用でき、これらの中からプロセス条件、原盤10およびヘッド基台12の材質等に応じて適宜選択される。

分離層 2 6 の形成方法としては、特に限定されるものではなく、分離層 2 6 の 組成や形成膜厚に応じて適宜選択される。具体的には例えば、CVD、蒸着、ス パッタリング、イオンプレーティング等の各種気層成長法、電気メッキ、無電解 メッキ、ラングミュア・ブロジェット(LB)法、スピンコート法、ディッピング法、スプレーコート法、ロールコート法、バーコート法等が利用できる。

分離層 26 の厚さは、剥離目的や分離層 26 の組成等により異なるが、通常は、1 nm ~ 20 μ m であることが好ましく、さらに好ましくは 10 nm ~ 20 μ m、さらに好ましくは 40 nm ~ 1 μ m 程度である。分離層 26 の厚さが薄すぎるとヘッド基台 12 へのダメージが大きくなり、また、膜厚が厚すぎると、分離層 26 の良好な剥離性を確保するために必要な照射光の光量を大きくしなければならない。なお、分離層 26 の膜厚は、できるだけ均一であることが好ましい。

そして、剥離後に分離層26の残骸を洗浄処理等を施すことにより除去する。 (第4工程)

第3工程において得られたヘッド基台12上にインク吐出用ノズル口13を形成する工程である。

インク吐出用ノズルロ13の形成方法としては、特に限定されるものではなく、 具体的に例えば、リソグラフィ法、レーザ加工、FIB加工、放電加工等が利用 できる。

図9は、リソグラフィ法によりインク吐出用ノズルロ13を形成する工程を示す図である。具体的には、以下の方法により行う。

まず、図9(a)に示すように、ヘッド基台12上にレジスト層15を形成する。

レジスト層 1 5 を形成する物質および方法としては、図 2 において説明した物質および方法と同一のものが利用できるため説明を省略する。

次に、図9(b)に示したように、マスク27をレジスト層15の上に配置し、マスク27を介してレジスト層15の所定領域のみに光17を照射して、露光領域18を形成する。

マスク27は、図9(e)に示すインク吐出用ノズル口13に対応した領域においてのみ、光17が透過するようにパターン形成されたものである。

そして、レジスト層 1 5 を露光した後、所定の条件で現像処理を行うと、図 9 (c)に示すように、露光領域 1 8 のレジストのみが選択的に除去されてヘッド基台 1 2 が露出し、それ以外の領域はレジスト層 1 5 により覆われたままの状態

となる。

こうしてレジスト層15がパターン化されると、図9(d)に示すように、このレジスト層15をマスクとしてヘッド基台12を貫通するまでエッチングする。

エッチングの方法としてはウエット方式またはドライ方式があるが、インクジェット基台12の材質に応じて、エッチング断面形状、エッチングレート、面内均一性等の点から適宜選択される。制御性の点からいうとドライ方式の方が優れており、例えば、平行平板型リアクティブイオンエッチング(RIE)方式、誘導結合型(ICP)方式、エレクトロンサイクロトロン共鳴(ECR)方式、ヘリコン波励起方式、マグネトロン方式、プラズマエッチング方式、イオンビームエッチング方式等の装置が利用でき、エッチングガス種、ガス流量、ガス圧、バイアス電圧等の条件を変更することにより、インク吐出用ノズルロ13を矩形に加工したり、テーパーを付けたりと、所望の形状にエッチングすることができる。

次に、エッチング完了後に、図9 (e) に示すように、レジスト層15を除去すると、インク吐出用ノズル口13が形成しされたヘッド基台12が得られる。

また、レーザ加工に用いるレーザ装置としては、各種気体レーザ、固体レーザ (半導体レーザ)等が利用できるが、KrF等のエキシマレーザ、YAGレーザ、Arレーザ、He-Cdレーザ、 CO_2 レーザ等が好適に用いられ、その中でもエキシマレーザが好適である。

エキシマレーザは、短波長領域で高エネルギーのレーザ光を出力するため、極めて短時間で加工ができ、よって、生産性が高い。

リソグラフィ法によれば、一度に複数箇所のインク吐出用ノズルロ13を形成 することが可能であるが、設備コストおよび材料コストが高く、必要となる設備 スペースも広くなる。

一方、レーザ加工、FIB加工および放電加工は、インク吐出用ノズル口13を一箇所毎に形成するため生産性に劣るが、低設備コスト化、低材料コスト化および省スペース化に優れる。

以上に述べたヘッド基台の製造方法によれば、原盤10は、一旦製造すればその後、耐久性の許す限り何度でも使用できるため、2枚目以降の導光体の製造工程において省略でき、工程数の減少および低コスト化を図ることができる。

次に、上記実施形態において形成されたヘッド基台12に、圧電素子を形成する工程の一例を、図10を用いて説明する。この工程よれば、圧電素子は、一旦、第3の原盤28上に形成されてから、ヘッド基台12上に転写される。 具体的には、以下の方法により行う。

まず、図10(a)に示すように、第3の原盤28上に共通電極29、圧電体薄膜30および上電極31を順次積層する。

第3の原盤28は、圧電体薄膜30および上電極31をパターニングして素子化する際の支持体としての役目を担うものであり、プロセス耐性、特に、耐熱性や機械的強度を有するものが好ましい。また、圧電体薄膜30および上電極31をパターニングした後の工程においてヘッド基台12と接合(接着)された後、共通電極29と第3の原盤28との界面で剥離されることになるため、第3の原盤28は共通電極29と密着性のあまり高くないものが好ましい。

共通電極29および上電極31としては、導電率の高いものであれば特に限定されるものではなく、例えば、Pt、Au、Al、Ni、In等が利用できる。また、共通電極29および上電極31の形成方法としては、これらの材質や形成膜厚に応じて適宜選択すれば良く、例えば、スパッタリング、蒸着、CVD、電気メッキ、無電解メッキ等が利用できる。

圧電体薄膜30としては、インクジェットプリンタ用には、ジルコン酸チタン酸鉛(PZT)系が好適である。PZT系の成膜方法としては、ゾルゲル法が好適である。ゾルゲル法によれば、簡便な方法でで良質の薄膜が得られる。

所定の成分に調整した P Z T 系ゾルを、共通電極 2 9 上にスピンコートで塗布 して仮焼成するという工程を所定回数繰り返すことにより非晶質のゲル薄膜を形成し、その後さらに本焼成してペロブスカイト結晶構造を有する圧電体薄膜 3 0 を得る。

なお、圧電体薄膜30の形成方法としては、ゾルゲル法以外にスパッタ法を用いてもい。

次に、図10(b)に示すように、図10(c)のヘッド基台12のインク圧力室33のパターンに応じて、圧電体薄膜30および上電極31をパターニングして圧電素子32とする。

パターニング方法としては、例えば、図12に示すリソグラフィ法が利用できるため説明を省略する。

次に、図10(c)に示すように、共通電極29および圧電素子32が形成された第3の原盤28に、図1の工程によって得られたヘッド基台12を接合、もしくは接着層34を介して貼り合わせる。

接着層34としては、ヘッド基台12、共通電極29および圧電素子32の材質に応じて適宜選択すれば良い。

そして、図10(d)に示すように、ヘッド基台12、共通電極29および圧電素子32を一体的に第3の原盤上28から剥離する。

もし、第3の原盤28と共通電極29との密着性が高く、剥離が困難となる場合には、前記図7の工程で説明したのと同様に、照射光を照射することにより剥離を促進させてもよく、さらには、図8に示すように分離層を設けてもよい。

こうしてヘッド基台12上に圧電素子32が形成されると、この後さらに、配線パターン、信号回路、インクタンク等と組み合わせてインクジェットプリンタ ヘッドを得る。

請求の範囲

1. インク圧力室を形成するヘッド基台上に設けられた電気信号により変形する圧電素子により、前記インク圧力室を加圧してインクを吐出するインクジェットプリンタヘッドの製造方法において、

前記へッド基台の製造工程は、前記へッド基台に応じた所定の凹凸パターンを 有する原盤を製造する第1工程と、前記原盤の凹凸パターンを有する表面上に前 記へッド基台形成用材料を塗布、固化させることにより前記へッド基台を形成す る第2工程と、前記ヘッド基台を前記原盤から剥離する第3工程と、前記ヘッド 基台上にインク吐出用ノズルロを形成する第4工程と、を含むことを特徴とする インクジェットプリンタヘッドの製造方法。

- 2. 請求項1に記載のインクジェットプリンタヘッドの製造方法において、前記第1工程は、原盤母材上に所定のパターンに応じたレジスト層を形成し、次いで、エッチングによって前記原盤母材上に前記凹凸パターンを形成して前記原盤を製造する工程を含むことを特徴とするインクジェットプリンタヘッドの製造方法。
- 3. 請求項2に記載のインクジェットプリンタヘッドの製造方法において、 前記原盤母材は、シリコンウエハであることを特徴とするインクジェットプリ ンタヘッドの製造方法。
- 4. 請求項2に記載のインクジェットプリンタヘッドの製造方法において、 前記原盤母材は、石英ガラスであることを特徴とするインクジェットプリンタ ヘッドの製造方法。
- 5. 請求項1に記載のインクジェットプリンタヘッドの製造方法において、 前記第1工程は、第2の原盤上に所定のパターンに応じたレジスト層を形成し、 次いで、前記第2の原盤およびレジスト層を導体化し、さらに電気メッキ法によ

り金属を電着させて金属層を形成した後、該金属層を前記第2の原盤およびレジスト層から剥離して前記原盤を製造する工程を含むことを特徴とするインクジェットプリンタヘッドの製造方法。

- 6. 請求項1に記載のインクジェットプリンタヘッドの製造方法において、 前記ヘッド基台形成用材料は、エネルギーの付与により硬化可能な物質である ことを特徴とするインクジェットプリンタヘッドの製造方法。
- 7. 請求項 6 に記載のインクジェットプリンタヘッドの製造方法において、 前記エネルギーは、光、熱、あるいは光および熱の双方のいずれかであること を特徴とするインクジェットプリンタヘッドの製造方法。
- 8. 請求項1に記載のインクジェットプリンタヘッドの製造方法において、 前記ヘッド基台は、熱可塑性の物質により形成されることを特徴とするインク ジェットプリンタヘッドの製造方法。
- 9. 請求項8に記載のインクジェットプリンタヘッドの製造方法において、 前記熱可塑性の物質は、水和ガラスであること特徴とするインクジェットプリ ンタヘッドの製造方法。
- 10. 請求項1に記載のインクジェットプリンタヘッドの製造方法において、 前記原盤上に形成された凹凸パターンの凹部形状は、開口部が低部より大きい テーパ形状であることを特徴とするインクジェットプリンタヘッドの製造方法。
- 11. 請求項1に記載のインクジェットプリンタヘッドの製造方法において、 前記凹凸パターンを有する原盤表面に、前記ヘッド基台との密着性の低い材質 からなる離型層が形成されていることを特徴とするインクジェットプリンタヘッ ドの製造方法。

WO 98/46431 PCT/JP98/01678

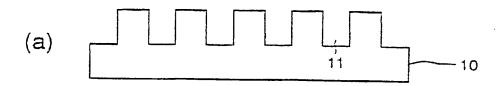
20

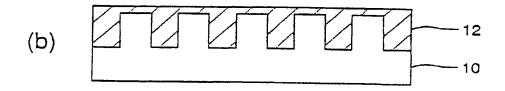
- 12. 請求項1に記載のインクジェットプリンタヘッドの製造方法において、 前記第3工程において、前記原盤とヘッド基台の界面に照射光を照射すること により、前記ヘッド基台を前記原盤から剥離せしめることを特徴とするインクジェットプリンタヘッドの製造方法。
- 13. 請求項12に記載のインクジェットプリンタヘッドの製造方法において、前記原盤とヘッド基台との間に分離層を設け、前記原盤と分離層の界面に前記照射光を照射することにより、前記分離層の内部および/または前記原盤との界面において、前記ヘッド基台を前記原盤から剥離せしめることを特徴とするインクジェットプリンタヘッドの製造方法。
- 14. 請求項1に記載のインクジェットプリンタヘッドの製造方法において、前記第4工程は、リソグラフィ法により前記インク吐出用ノズル口を形成することを特徴とするインクジェットプリンタヘッドの製造方法。
- 15. 請求項1に記載のインクジェットプリンタヘッドの製造方法において、 前記第4工程は、レーザ光により前記インク吐出用ノズル口を形成することを 特徴とするインクジェットプリンタヘッドの製造方法。
- 16. 請求項1に記載のインクジェットプリンタヘッドの製造方法において、 前記第4工程は、収束イオンビームにより前記インク吐出用ノズル口を形成す ることを特徴とするインクジェットプリンタヘッドの製造方法。
- 17. 請求項1に記載のインクジェットプリンタヘッドの製造方法において、 前記第4工程は、放電加工により前記インク吐出用ノズル口を形成することを 特徴とするインクジェットプリンタヘッドの製造方法。
- 18. 請求項1から請求項17のいずれかに記載のインクジェットプリンタへッドの製造方法により製造されたことを特徴とするインクジェットプリンタへッ

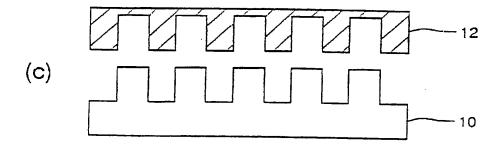
WO 98/46431 PCT/JP98/01678

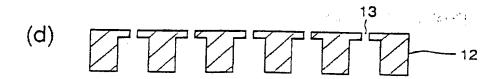
21

ド。

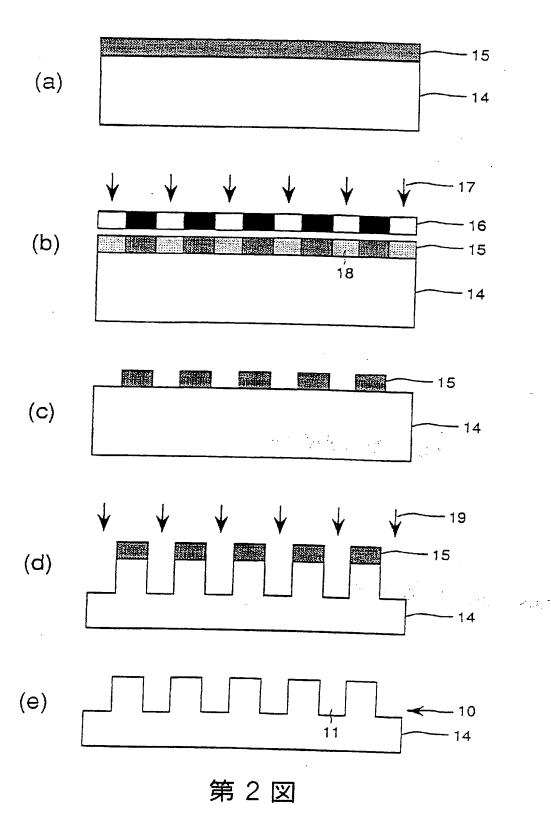


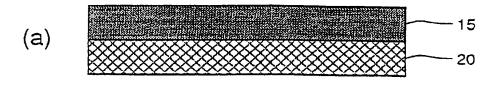


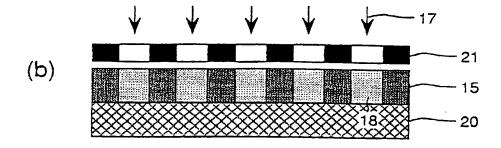


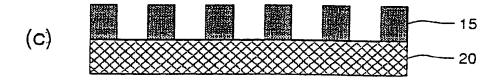


第 1 図

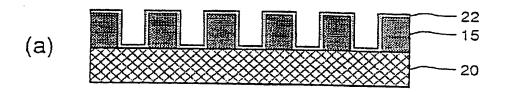


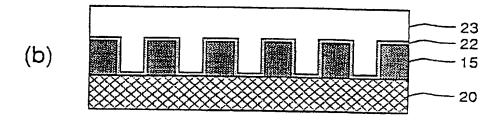


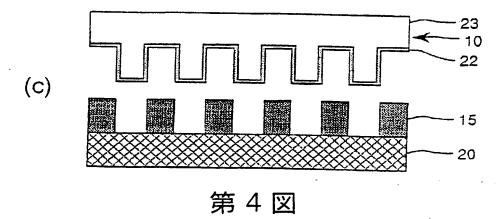


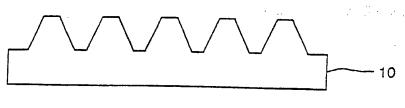


第 3 図

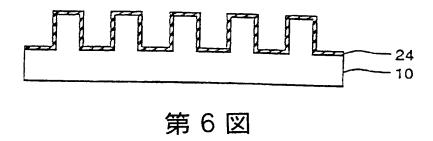


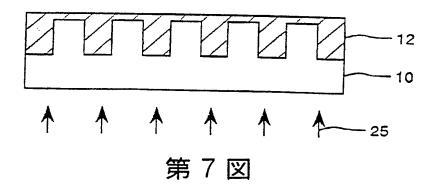


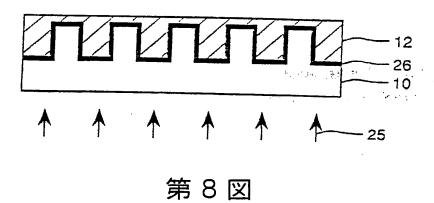


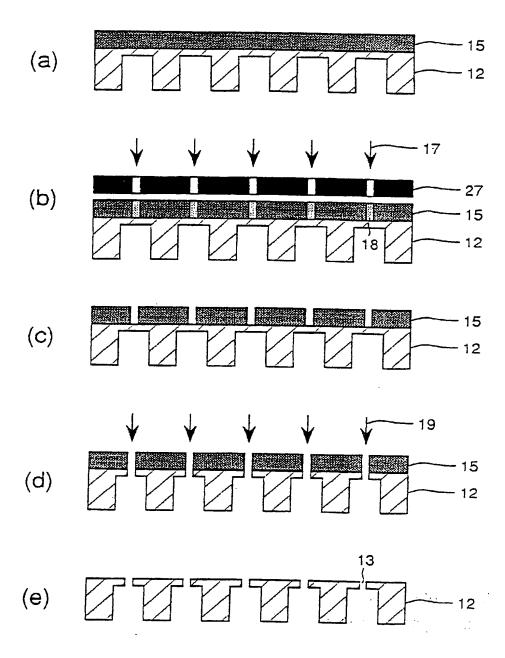


第 5 図

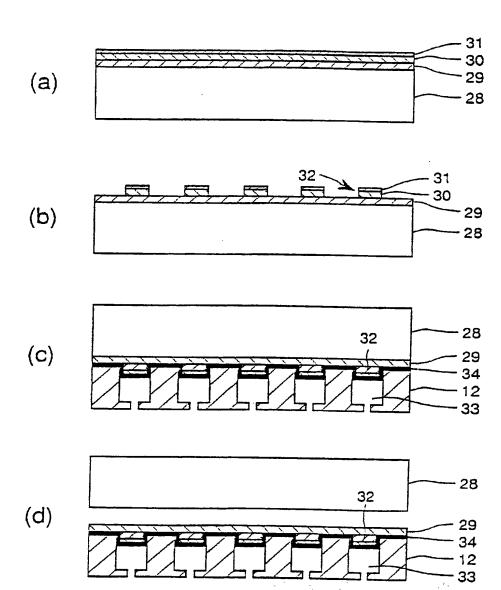






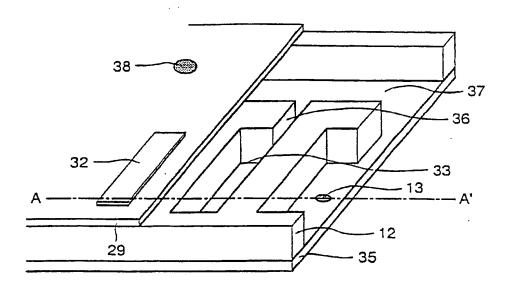


第 9 図

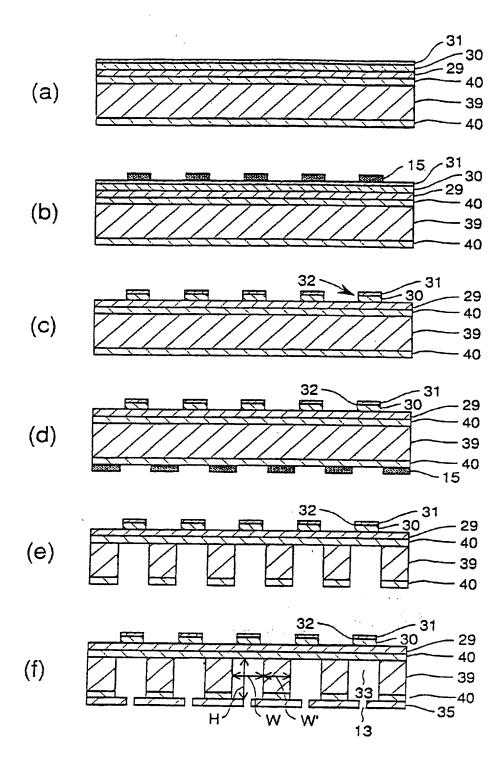


第10図

8/9



第11図



第12図

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP98/01678

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁶ B41J2/16, B41J2/045, B41J2/055					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELD	S SEARCHED				
Int.	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁶ B41J2/16, B41J2/045, B41J2/055				
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1998 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1998 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1998					
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)					
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Relevant to claim No.		
¥1	JP, 6-23994, A (Fujitsu Ltd. February 1, 1994 (01. 02. 94		1-11, 14-18		
Y1	JP, 6-23993, A (Fujitsu Ltd.), February 1, 1994 (01. 02. 94) (Family: none)				
Y1 Y2	JP, 4-131244, A (Seiko Epson Corp.), May 1, 1992 (01. 05. 92) (Family: none) 1-11, 14-18 6-8, 14-17				
¥2	JP, 4-45950, A (Seiko Epson Corp.), 2, 6-8 February 14, 1992 (14. 02. 92) (Family: none)				
¥2	JP, 55-118877, A (Canon Inc.), 2-5 September 12, 1980 (12. 09. 80) (Family: none) 14-17				
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date or priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other			ion but cited to understand vention aimed invention cannot be d to involve an inventive step aimed invention cannot be when the document is		
	ent published prior to the international filing date but later than ority date claimed	combined with one or more other such d being obvious to a person skilled in the a "&" document member of the same patent far	art		
	actual completion of the international search 26, 1998 (26. 06. 98)	Date of mailing of the international sear July 7, 1998 (07.			
	Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.			

THIS PAGE BLANK (USPILL)

国際出願番号 PCT/JP98/01678

A. 発明の属	はする分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl ⁶ B41J 2	/16	
	B41J 2	2/045	
	B41J 2	2/055	
B. 調査を行	テった分野		
周査を行った最	k小限資料(国際特許分類(IPC))		
	Int. Cl B41J 2 B41J 2		
		2/055	
	which could be a second by the		
表小限資料以 列	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報	1926-1996	
		1971-1998	
	*** ***********************************	1994-1998	
	日本国実用新案登録公報	1996-1998	
国際調査で使用	用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)	
0 883年十	フル部 込 と み て 立森b		
C. 関連する 引用文献の	ると認められる文献 		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
Y1	JP,6-23994,A(富士通株式会社)1.2月 ファミリーなし	1. 1994 (01. 02. 94)	1-11, 14-18
Y1	ファミリーなし JP, 6−23993, A(富士通株式会社)1.2月 ファミリーなし	1. 1994 (01. 02. 94)	-1-11, 14-18
Y1	JP, 4-131244, A(セイコーエプ ソン株式会社)	1.5月.1992(01.05.92)	1-11, 14-18
Y2	ファミリーなし		6-8, 14-17
Y2	JP, 4-45950, A(セイコーエア・ソン株式会社) 14. 2月. 1992(14. 02. 92) 2, 6-8 ファミリーなし		
Y2	JP,55-118877,A(キャノン株式会社)12.9 ファミリーなし	月. 1980 (12. 09. 80)	2-5 14-17
	1944 D		
□ C欄の続	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
	のカテゴリー	の日の後に公表された文献	
	連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表 て出願と矛盾するものではなく	
もの 「E : 先行文i	献ではあるが、国際出願日以後に公表されたも		、元切りが全人は
の		「X」特に関連のある文献であって、	当該文献のみで発
	主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行		えられるもの
	くは他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す)	「Y」特に関連のある文献であって、 上の文献との、当業者にとって	コ政文献と他のII 自明である組合せ
	_{埋田を刊9} り よる開示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられ	
	願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献	
国際調査を完	アした日	国際調査報告の発送日	
ENDAMAR C. /L	26. 06. 98	07.	07. 98
国際調本機即		特許庁審査官(権限のある職員)	2C 781
	国特許庁(ISA/JP)	芝哲央	
	郵便番号100-8915		7
東京	都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	四縣 3222

①3, 8, 11 知的財産室

拒絕理由通知書

特許出願の番号

平成 9年 特許願 第097780号

起案日

平成15年 6月 4日

特許庁審査官

江成 克己 7907 2 P 0 0

特許出願人代理人

上柳 雅誉(外 1名) 様

適用条文

第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

FP03297

理 由

この出願の請求項1-11、14-18に係る発明は、その出願前日本国内において頒布された下記の刊行物1に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない

記

1.特開平6-23993号公報 引例手配箱

(本願の請求項2-9に示された鋳型の材質、鋳型の作り方は格別のものではない。例えば特開昭55-118877号公報P. 2右下欄には鋳型を感光性ガラスで作ることなどその材質について記載されている。同じくP. 3左上欄には電気メッキで鋳型をつくることが記載されている。請求項10の形状の限定はどのようなインクジェットへッドかによって決まりかつその形状はインクジェットへッドとして格別のものではない。請求項11の離型剤の使用は上記公報【0020】に記載されている。請求項14-17のノズル孔の開け方も、プラスチックやセラミックに孔を空けるなどの切削加工をするときのよく知られた方式である。例えば特開平4-131244号公報にはインクジェットへッド用部材に(インクが通る点ではノズル孔と共通の)インク供給路を空けるのにレーザを使うことが記載されている。)

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、 現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には 拒絶の理由が通知される。

- ・調査した分野 IPC第7版 B41J2/045,2/055
- ・先行技術文献 特開平4-45950号公報・特開平6-23994号公報 引例手配済 引例手配済

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

E P



РСТ

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 P3297WO-RD	今後の手続きについては、	国際調査報告の及び下記5を参	送付通知様式(PCT/ISA/220) 照すること。		
国際出願番号 PCT/JP98/01678	国際出願日 (日.月.年) 10.0		先日 日.月.年) 15.04.97		
出願人(氏名又は名称) セイコーエプソン株式会社					
					
国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 この写しは国際事務局にも送付される。					
この国際調査報告は、全部で2	ページである。				
この調査報告に引用された先行打	支術文献の写しも添付されて 	いる。			
1. 調求の範囲の一部の調査が	ができない (第 I 欄参照) 。		•		
2. 発明の単一性が欠如してい	いる(第Ⅱ欄参照)。				
3. □ この国際出願は、ヌクレス 査を行った。	ナチド及び/又はアミノ酸酯	!列リストを含ん	でおり、次の配列リストに基づき国際調		
□ この国際出願と共に提出	出されたもの		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
□ 出願人がこの国際出願とは別に提出したもの					
しかし、出願時の国	国際出願の開示の範囲を越え	る事項を含まな	い旨を記載した書面が添付されていない		
□ この国際調査機関が書換えたもの					
4. 発明の名称は 🛛 🗓 出願	頭人が提出したものを承認す	· る。、			
□ 次局	こ示すように国際調査機関が	作成した。			
-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
 5. 要約は X 出願	頭人が提出したものを承認す	・ス			
			条(PCT規則38.2(b))の規定により		
国際		人は、この国際	調査報告の発送の日から1カ月以内にこ		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	コロハッチュログストで 元で 近日 ソ	-5 C 1/2 C C 10;			
6. 要約書とともに公表される図は、					
第 <u>1</u> 図とする。区出願(a)~(d)			□ なし		
	頼人は図を示さなかった。	÷			
本図	図は発明の特徴を一層よく表	している。			

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. C16

2/16 B41J

2/045 B41J

2/055 B 4 1 I

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl⁶ B41J 2/16

B41J 2/045

B 4 1 J 2/055

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926 - 1996

日本国公開実用新案公報

1971 - 1998

日本国登録実用新案公報

1994-1998

日本国実用新案登録公報

1996 - 1998

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y1	JP, 6-23994, A(富士通株式会社)1.2月.1994(01.02.94) ファミリーなし	1-11, 14-18
Y1	JP, 6-23993, A(富士通株式会社)1.2月.1994(01.02.94) ファミリーなし	1-11, 14-18
Y1 Y2 Y2	JP, 4-131244, A(セイコーエア ソン株式会社) 1.5月.1992 (01.05.92) ファミリーなし JP, 4-45950, A(セイコーエア ソン株式会社) 14.2月.1992 (14.02.92)	1-11, 14-18 6-8, 14-17 2, 6-8
Y2	│ ファミリーなし │ JP, 55-118877, A(キャノン株式会社) 12. 9月. 1980 (12. 09. 80)	2-5
	ファミリーなし	14-17

| | C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたも
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

26.06.98

国際調査報告の発送日

07.07.98

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員)

哲 央



2 C 7810

電話番号 03-3581-1101 内線 3222



PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 P3297WO-RD	$r \rightarrow r \rightarrow$					
国際出願番号						
出願人(氏名又は名称) セイコーエプソン株式会社						
国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 この写しは国際事務局にも送付される。						
この国際調査報告は、全部で2	この国際調査報告は、全部で2 ページである。					
この調査報告に引用された先行	技術文献の写しも添付されている。					
1. 請求の範囲の一部の調査	ができない(第I欄参照)。					
2. □ 発明の単一性が欠如している(第Ⅱ欄参照)。						
3. □ この国際出願は、ヌクレオチド及び/又はアミノ酸配列リストを含んでおり、次の配列リストに基づき国際調査を行った。						
□ この国際出願と共に提出されたもの						
出願人がこの国際出願とは別に提出したもの						
□ しかし、出願時の国際出願の開示の範囲を越える事項を含まない旨を記載した書面が添付されていない						
□ この国際調査機関が書換えたもの						
	順人が提出したものを承認する。					
	に示すように国際調査機関が作成した。					
	All the state of t					
5. 要約は 🗓 🗓	H願人が提出したものを承認する。					
	第Ⅲ欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により 国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ ○国際調査機関に意見を提出することができる。					
6. 要約書とともに公表される図は 第 <u>1</u> 図とする。区 出 (み)~(み)	は、 出願人が示したとおりである。					
[H	出願人は図を示さなかった。					
→ 本図は発明の特徴を一層よく表している。						



	国際調査報告	国際出願番号 PCT/JP9	8/01678		
A. 発明の履	A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl ^e B41J 2/16 B41J 2/045 B41J 2/055				
B. 調査を行 調査を行った最	調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))				
Int. C1° B41J 2/16 B41J 2/045 B41J 2/055					
最小限資料以外	最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996 日本国公開実用新案公報 1971-1998 日本国登録実用新案公報 1994-1998 日本国実用新案登録公報 1996-1998				
国際調査で使用	国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)				
C. 関連する	ると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
Y1	JP,6-23994,A(富士通株式会社)1.2月. ファミリーなし	1994 (01. 02. 94)	1-11, 14-18		
Y1	JP,6-23993, A(富士通株式会社)1.2月. ファミリーなし	1994 (01. 02. 94)	1-11, 14-18		
Y1 Y2 Y2	JP, 4-131244, A(セイコーエプ ソン株式会社) 1. ファミリーなし JP, 4-45950, A(セイコーエプ ソン株式会社) 14.		1-11, 14-18 6-8, 14-17 2, 6-8		
Y2	ファミリーなし JP, 55-118877, A (キャノン株式会社) 12.9月 ファミリーなし		2-5 14-17		
□ C欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。					
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する大数(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「SUの日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって、出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの「&」同一パテントファミリー文献					
国際調査を完了した日 26.06.98 国際調査報告の発送日 07.07.98					

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員) 哲 央

2 C 7810

電話番号 03-3581-1101 内線 3222

日本国特許庁(ISA/JP)

国際調査機関の名称及びあて先

NOV.- 4.1998

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

SUZUKI, Kisaburo Intellectual Property Dept. Seiko Epson Corporation 3-5, Owa 3-chome Suwa-shi Nagano-ken 392-8502 JAPON

Date of mailing (day/month/year)

22 October 1998 (22.10.98)

Applicant's or agent's file reference

P3297WO-RD

IMPORTANT NOTICE

International application No. PCT/JP98/01678

International filing date (day/month/year)

10 April 1998 (10.04.98)

Priority date (day/month/year) 15 April 1997 (15.04.97)

Applicant

SEIKO EPSON CORPORATION et al

Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application
to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:
 CN.EP.KR.US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

SG

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

 Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 22 October 1998 (22.10.98) under No. WO 98/46431

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the **national phase**, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

J. Zahra

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 B41J 2/16, 2/045, 2/055

(11) 国際公開番号 A1 WO98/46431

(43) 国際公開日

1998年10月22日(22.10.98)

(21) 国際出願番号

PCT/JP98/01678

(22) 国際出願日

1998年4月10日(10.04.98)

(30) 優先権データ

特願平9/97780

1997年4月15日(15.04.97)

JP

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) セイコーエプソン株式会社

(SEIKO EPSON CORPORATION)[JP/JP]

〒163-0811 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

西川尚男(NISHIKAWA, Takao)[JP/JP]

高桑敦司(TAKAKUWA, Atsushi)[JP/JP]

〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号

セイコーエプソン株式会社内 Nagano, (JP)

(74) 代理人

弁理士 鈴木喜三郎,外(SUZUKI, Kisaburo et al.)

〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号

セイコーエプソン株式会社 知的財産部内 Nagano, (JP)

(81) 指定国 CN, KR, SG, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開書類

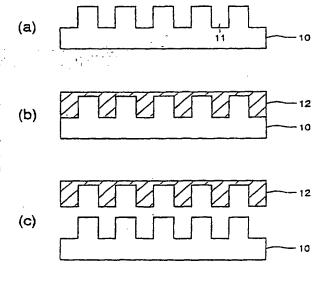
国際調査報告書

(54)Title: INK JET PRINTER HEAD AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

(54)発明の名称 インクジェットプリンタヘッドおよびその製造方法

(57) Abstract

A method for manufacturing an ink jet printer head which can cope with the tendency toward resolution improvement at a low cost through simple steps. Specifically, a method for manufacturing an ink jet printer head which jets ink by pressurizing an ink pressurizing-chamber by means of a piezoelectric element that is provided on a head base forming the ink pressurizing chamber and deformed by an electric signal, wherein a method for manufacturing the head base comprises the first step of manufacturing a master disk (10) having an uneven pattern corresponding to that of the head base, the second step of forming the head base (12) by applying and solidifying a head base forming material to and on the surface of the master disk (10) carrying the uneven pattern, the step of releasing the head base (12) from the master disk (10), and the fourth step of forming ink jet nozzle openings (13) in the head base (12).





PCT REQUEST

The undersigned requests that the present

For receiving Office use only			
International Application No.			
.*			
International Filing Date			
Name of receiving Office and "PCT International Application"			

international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty	Name of receiving Of	ffice and "PCT International Application"		
according to the ratent cooperation fronty	Applicant's or agent's	s file reference P3297WO-RD cters maximum)		
Box No. I TITLE OF INVENTION				
Ink Jet Printer Head And Manufacturing Method The	reof			
Box No. II APPLICANT				
Name and address: (Family name followed by given name: for a legal er	ntity, full official designation.	This person is also inventor.		
The address must include postal code and name of country. The country of is the applicant's State (i.e. country) of residence if no State of residence is	the address indicated in this Box indicated below.)	Telephone No		
Seiko Epson Corporation				
4-1, Nishi-shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo,	163-0811 JAPAN	Facsimile No		
4-1, Mishi-shinjuku 2-chome, Ohinjuku-ku, Tokyo,	100-0077 0711 7111	Teleprinter No.		
		-		
State (i.e. country) of nationality: JAPAN	State (i.e. country) of no	ationality:		
This person is applicant all designated all designated all designated		United States		
Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTH	IER) INVENTOR(S)			
Name and address: (Family name followed by given name: for a legal en The address must include postal code and name of country. The country of t		This person is:		
is the applicant's State (i.e. country) of residence if no State of residence is	indicated below.)	applicant only		
NISHIKAWA Takao		applicant and inventor		
c/o Seiko Epson Corporation				
3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-85	02 JAPAN	☐ inventor only (if this check box is marked, do not fill in below)		
State (i.e. country) of nationality: JAPAN	State (i.e. country) of n	ationality:		
1. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		United States		
Further applicants and/or (further) inventors are indicated or	n a continuation sheet.			
Box No. IV AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE;	OR ADDRESS FOR CORRE	SPONDENCE		
The person identified below is hereby/has been appointed to act on b of the applicant(s) before the competent International Authorities as:	ehalf 🛚 agent	common representative		
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal The address must include postal code and name of		Telephone No 0266-52-3139		
9338 SUZUKI Kisaburo				
9572 KAMIYANAGI Masataka		Facsimile No		
10726 SUZAWA Osamu		0266-58-3243		
c/o Intellectual Property Department		Teleprinter No.		
Seiko Epson Corporation 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken, 392-8	502 JAPAN			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Mark this check-box where no agent or common representat a special address to which correspondence should be sent		the space above is used instead to indicate		

Sheet No.	3	he	et	Ν	٥.		2
-----------	---	----	----	---	----	--	---

Box No. III	FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURT	HER) INVENTOR(S)		
	If none of the following sub-boxes is used, this sheet is not to be included in the request.			
Name and address:	(Family name followed by given name; for a lega The address must include postal code and name	al entity, full official designation. of country.)	This person is:	
TAICALC	A		applicant only	
TAKAKUWA	AKAKUWA Atsushi			
	son Corporation nome, Suwa-shi, Nagano-ken, 392-i	8502 JAPAN	inventor only (if this check box is marked, do not fill in below)	
State (i.e. country	State (i.e. country) of nationality: State (i.e. country) of nationality:			
JAPAN		JAPAN	<u> </u>	
This person is applicant for the purposes of:	States the Unite	d States of America of Am	United States the States indicated in the Supplemental Box	
Name and address:	(Family name followed by given name; for a lega The address must include postal code and name		This person is:	
			applicant only	
			applicant and inventor	
			inventor only (if this check box is marked, do not fill in below)	
State (i.e. country	c) of nationality	State (i.e. country) of na	ationality:	
State (i.e. Country	y of nationality.	State (i.e. country) of the		
This person is applicant for the purposes of:			United States	
Name and address:	(Family name followed by given name; for a lega The address must include postal code and name	al entity, full official designation.	This person is:	
		. /	applicant only	
			applicant and inventor	
			inventor only (if this check box is marked, do not fill in below)	
	·			
State (i.e. country	v) of nationality:	State (i.e. country) of na	ationality:	
This person is applicant for the purposes of:			United States	
Name and address:	(Family name followed by given name; for a lega The address must include postal code and name		This person is:	
	·		applicant only	
			applicant and inventor	
			inventor only (if this check box is marked, do not fill in below)	
State (i.e. country	/) of nationality:	State (i.e. country) of na	Lationality:	
This person is applicant for the purposes of:	_ , _ ,		United States the states indicated in the Supplemental Box	
☐ Further appl	icants and/or (further) inventors are indicated			
Form BCT/DO404 /	entinuation sheet) (January 1997)		See Notes to the request form	

Sheet N	0.
---------	----

Box No. V	D. V DESIGNATION OF STATES		
The following designations are hereby made Rule 4.9(a) (mark the applicable check-boxes; at least one must be marked):			
Regional P	Patent		
□АР	ARIPO Patent: KE Kenya, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SZ Swaziland, UG Uganda, and any other State which is a Contracting State of the Harare Protocol and of the PCT		
□ EA	Eurasian Patent: AM Armenia, AZ Azerbaijan, BY Belarus, KG Kyrgyzatan, KZ Kazakstan, MD Republic of Moldova, RU Russian Federation, TJ Tajikistan, TM Turkmenistan, and any other State which is a Contracting State of the Eurasian Patent Convention of the PCT		
⊠ EP	European Patent: AT Austria, BE Belgium, CH and LI Switzerland and Liechtenstein, DE Germany, DK Denmark, ES Spain, FI Finland, FR France, GB United Kingdom, GR Greece, IE Ireland, IT Italy, LU Luxembourg, MC Monaco, NL Netherlands, PT Portugal, SE Sweden, and any other State which is a Contracting State of the European Patent Convention and of the PCT		
□ OA	OAPI Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Central African Republic, CG Congo, CI Cote d'Ivoire, CM Cameroon, GA Gabon, GN Guinea, ML Mali, MR Mauritania, NE Niger, SN Senegal, TD Chad, TG Togo, and any other State which is a member State of OAPI and a Contracting State of the PCT (if other kind of protection or treatment desired, specify on dotted line)		
National P	Patent (if other kind of protection or treatment desire		
1	ınia	LU Luxembourg	
AM Arm	nenia	LV Latvia	
AT Aust	tria	MD Republic Moldova	
AU Aus	tralia	MG Madagascar	
BA Bosi	nia and Herzegovina	MK The former Yugoslav Republic of Macedonia	
BB Bart	pados	MN Mongolia	
BG Bulg	garia	MW Malawi	
BR Braz	zil	MX Mexico	
BY Bela	ırus	NO Norway	
CA Can	ada	NZ New Zealand	
CH and LI Switzerland and Liechtenstein		PL Poland	
CN China		PT Portugal	
CZ Cze	ch Republic	RO Romania	
. —	many	RU Russian Federation	
DK Den	mark	SD Sudan	
EE Estonia		SE Sweden	
	in	SG Singapore	
FI Finla	nd	SI Slovenia	
GB United Kingdom		SK Slovakia	
GE Georgia		TJ Tajikistan	
	ngary	TM Turkmenistan :	
S Icelai	nd ·	TR Turkey	
DP Japa	an	TT Trinidad and Tobago	
1	ya	UA Ukraine	
	gyzstan	UG Uganda	
KR Rep	public of Korea	US United States of America	
KZ Kaza	akhstan		
LC Sain	nt Lucia	UZ Uzbekistan	
LD Sri L	_anka	VN Viet Nam	
LR Libe	ria	Check-boxes reserved for designating States (for the purposes of	
LS Leso	otho	a national patent) which have become party to the PCT after	
LT Lithu	uania	issuance of this sheet	
In addition	to the designations made above the applicant also		
	n to the designations made above, the applicant also in PCT except the designation(s) of	makes under mule 4.5(b) all designations which would be permitted	
The applicant declares that those additional designations are subject to confirmation and that any designation which is not confirmed			

before the expiration of 15 months from the priority date is to be regarded as withdrawn by the applicant at the expiration of that time limit. (Confirmation of a designation consists of the filing of a notice specifying that designation and the payment of the designation and

confirmation fees. Confirmation must reach the receiving Office within the 15-month time limit.)

		Sheet N	lo. 4		
Box No. VI PRIORITY			Further priority	claims are indicate	d in the Supplemental Box
The priority of the following earlie	r application(s) is h	nereby claimed:			
Country (in which, or for which, the application was filed)	Filing	g Date onth/year)	Applica	ation No.	Office of filing (only for regional or international application)
item (1)	15.0	04. 97		ent Application -97780	
Japan item (2)					
item (3)					
Mark the following check-box if the	ne certified copy of	f the earlier applica	ation is to be issue	ed by the Office which	ch for the purposes of the present
international application is the rec	ceiving Office (a fe	e may be required,) <i>:</i>		
The receiving Office is he	reby requested to p	orepare and transn	nit to the Internatio	onal	
Bureau a certified copy of				(1)	·
Box No. VII INTERNA Choice of International Searc	TIONAL SEARCH			erchina Authorities	
are competent to carry out the	international searc	h, indicate the Aut	hority chosen; the	two-letter code mag	y be used): ISA/ <u>JP</u>
Farlies accept Fill in whore a s	earch (internations	al international-tyr	e or other) by the	International Searce	hing Authority has already been
carried out or requested and the	e Authority is now	requested to base	the international	search, to the exten	t possible, on the results of that
earlier search. Identify such s	earch or request e	ither by reference	to the relevant ap	plication (or the tran	slation thereof) or by reference to
the search request					Number:
Country (or regional office)		Date (day/n	nonth/year):		
Box No. VIII CHECK L	IST				
This International application the following number of sheets		s International app	lication is accomp	anied by the item(s)	marked below:
1. request :		🛚 separate signe	d power of 5.	🛮 fee calculation	sheet
2. description: 17	7 sheets	attorney —			itions concerning deposited
3. claims :	2. 4 sheets	copy of general attorney		microorganisms	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
		statement expla		(diskette)	or amino acid sequence listing
	9 sheets	signature		other (specify)	•
5. drawings : S	4.	priority docume identified in Box	ent(s)		sending priority documents
	ngs (if any) should	items(s):	etraet when it is n	uhlishad	
	JRE OF APPLICAN		Stract when it is p		
3 000 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100					f such canacity is not obvious from
reading the request).	ne name ot tne per	son signing and in	е сараску пт write	ir the person signs (r	f such capacity is not obvious from
SUZUKI Kisal	buro				
KAMIYANAGI Masataka					
SUZAWA Osamu					
1. Date of actual receipt of the p		or receiving Office	use only —		2. Drawings:
international application:	purported				
3. Corrected date of actual rece	eipt due to later but				received:
timely received papers or drawings completing the purported international application: not received:					
4. Date of timely receipt of the required corrections under PCT Article 11(2):					
5. International Searching Authorspecified by the applicant:		6.	Transmittal of se	earch copy delayed is paid	
epocines by the applicant.		nternational Burea			
Date of receipt of the record co		mematura Durea	a de ony		

特許協力条約に基づく国際出願

願

書

国際出願番号	一受理官庁記入概	
国際出願日		
(受付印)		

出願人は、この国際出願が特許協力条 約に従って処理されることを請求する	(受付印)
和に促って処理されることを請求する	1
	│ 出願人又は代理人の書類記号 P 3 2 9 7 W O - R D (希望する場合、最大12字)
第I欄 発明の名称	「加工する毎日、政人12十)
インクジェットプリンタヘッドおよびその製造方法	
第Ⅱ欄 出願人	
氏名(名称)及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記	『載:あて名は郵便番号及77国名も記載)
	し」 この欄に記載した者は、
セイコーエプソン株式会社	発明者でもある。
Seiko Epson Corporation	電話番号:
〒163-0811 日本国東京都新宿区西新宿二丁目4番1号	ファクシミリ番号:
4-1, Nishi-shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo,	163-0811 JAPAN
	加入電信番号:
国籍 (国名): 日本国 JAPAN	住所(国名): 日本国 JAPAN
この欄に記載した者は、次の 指定国についての出願人である: すべての指定国 🔀 米国を除	Rくすべての指定国
第 III 欄 その他の出願人又は発明者	一
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載:法人は公式の完全な名称を記	部・あて名け部周元号及75回夕・20歳) この間に記載しませば
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	載;あて名は郵便番号及び国名も記載) この欄に記載した者は 次に該当する:
西川 尚男 NISHIKAWA Takao	□ 出願人のみである。
〒302-8502 日本国長縣圓箍詩書士和二丁月2冊5日	·
〒392-8502 日本国長野県諏訪市大和三丁目3番5号 c/o Seiko Epson Corporation	セイコーエプソン株式会社内 📗 🖾 出願人及び発明者である。
3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken, 392-850	2 IAPAN 見明者のみである。
	くここにレ印を付したとき は、以下に記入しないこと)
	は、以下に超入しないこと)
卤籍(固名): 日本国 JAPAN	住所(国名): 日本国 JAPAN
この欄に記載した者は、次の	くすべての指定国 🛛 米国のみ 📗 追記欄に記載した指定国
○ その他の出願人又は発明者が続葉に記載されている。	
第 IV 欄 代理人又は共通の代表者、通知のあて名	
次に記載された者は、国際機関において出願人のために行動する:	大理人 共通の代表者
氏名(名称)及びあて名: (姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載	
	### 18 電話番号: 0266-52-3139
9 3 3 8 弁理士 鈴木 喜三郎 SUZUKI Kis	aburo
	GI Masataka ファクシミリ番号:
10726 弁理士 須澤 修 SUZAWA O	samu 0266-58-3243
〒392-8502 日本国長野県諏訪市大和三丁目3番5号	=====================================
セイコーエプソン株式会社 知的財産部内	
c/o Intellectual Property Department	加入電信番号:
Seiko Epson Corporation	
3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken, 392-8502	2 JAPAN
□ 代理人又は共通の代表者が選任されておらず、上記枠内に特に通知が	
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	はいされるめて名を配取している場合は、レ印を付す

2 頁

第 III 欄の続き その他の出願人又は発明者				
この続葉を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと。				
氏名(名称)及びあて名: (姓·名の順に記載:法人は公式の完全な名称を	記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は次に該当する:		
高桑 敦司 TAKAKUWA Atsushi		出願人のみである。		
一 〒392-8502 日本国長野県諏訪市大和三丁目3番5号	セイコーエプソン株式会社内	□ 出願人及び発明者である。		
c/o Seiko Epson Corporation 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken, 392-85	□ 発明者のみである。 (ここにレ甲を付したときは、以下に記入しないこと)			
国籍 <i>(国名)</i> : 日本国 JAPAN	住所 (国名): 日本国 JAP	AN		
この欄に記載した者は、次の すべての指定国 米国を		追記欄に記載した指定国		
指定国についての出願人である: 「公司を図し、「本図を図し、「本図を図し、「本図を図し、「大図の日本図」、「公司を図し、「本図の日本図」、「大図の日本図(名称)及びあて名: (姓・名の順に記載: 法人は公式の完全な名称を図		この欄に記載した者は		
		次に該当する:		
		□ 出願人のみである。		
		出願人及び発明者である。		
		□ 発明者のみである。 (ここにレ印を付したどきは、以下に記入しないこと)		
国籍 (国名):	住所 <i>(国名)</i> :			
この欄に記載した者は、次の すべての指定国 米国を指定国についての出願人である:	除くすべての指定国	追記欄に記載した指定国		
氏名(名称)及びあて名: (姓·名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記	記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は、次に該当する:		
		□ 出願人のみである。		
		出願人及び発明者である。		
国籍 <i>(国名)</i> :	住所 <i>(国名)</i> :			
この欄に記載した者は、次の	除くすべての指定国 🗌 米国のみ 📗	追記欄に記載した指定国		
氏名(名称)及びあて名: (姓·名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記	記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は 次に該当する:		
w.		□ 出願人のみである。		
		□ 出願人及び発明者である。		
·	·			
国籍 (国名):	住所 <i>(国名)</i> :			
この欄に記載した者は、次の	除くすべての指定国	追記欄に記載した指定国		
□ その他の出願人又は発明者が他の統葉に記載されている。				

THIS PAGE BLANK (600)

第V欄 国の指定	<u> </u>		
規則4.9(a)の規定に基づき次の指定を行う (該当する口にレ	印を付すこと:少なくとも1つの口にレ印を付すこと)。		
広域特許			
□AP ARIPO特許: KE ケニア Kenya, LS レ	ソト Kenya, MW マラウイ Malawi, SD スーダン Sudan,		
SZ スワジランド Swaziland, UG ウガンダ Uga	nda,及びハラレプロトコルと特許協力条約の締結国である他の国		
□EA ユーラシア特許: AM アルメニア Armenia, A	Z アゼルバイジャン Azerbaijan, BY ベラルーシ Belarus,		
KG キルギスタン Kyrgyzstan, KZ カザフスタン	Kazakstan, MD モルドヴァ Republic of Moldova, RU ロシア連邦		
Russian Federation, TJ タジキスタン Tajikistan.	TM トルクメニスタン Turkmenistan, 及びユーラシア特許条約と特許協		
力条約の締結国である他の国			
│ 図EP ヨーロッパ特許:AT オーストリア Austria, E	${f E}$ ベルギー Belgium, ${f C}{f H}$ and ${f L}{f I}$ スイス及びリヒテンシュタイン		
Switzerland and Liechtenstein, DE ドイツ Germany	, DK デンマーク Denmark, ES スペイン Spain, FI フィンラン		
ド Finland, F R フランス France, G B 英国 Unit	ed Kingdom, GR ギリシャ Greece, IE アイルランド Ireland, IT		
イタリア Italy, LU ルクセンブルグ Luxenbourg,	MC モナコ Monaco, NL オランダ Netherlands, PT ポルトガル		
Portugal, SE スウェーデン Sweden, 及びヨーロッ	ッパ特許条約と特許協力条約の締約国である他の国		
	Faso, BJ ベニン Benin, CF 中央アフリカ Central African Republic,		
CG コンゴー Congo CI 象牙海岸 Côte d'Ivoir	re, CM カメルーン Cameroon, GA ガボン Gabon, GN ギニア		
Guinea, ML マリ Mali, MR モーリタニア Mau	ritania NE = = = Niger		
	G トーゴー Togo, 及びアフリカ知的所有権機構と特許協力条約の締約国で		
ある他の国(他の種類の保護を求める場合には点線上は	三記載する)		
国内特許(他の種類の保護又は取扱いを求める場合には点線上に記			
□ AL アルバニア Albania	wyの) □LV ラトヴィア Larvia		
AM アルメニア Armenia			
	MD モルドバ Republic Moldova		
AT A-X-17 Austria	□MG マダガスカル Madagascar		
AU オーストラリア Australia	■MK マケドニア旧ユーゴスラビア The former Yugoslav Republic		
BA ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina	of Macedonia		
BB バルバドス Barbados	■MN モンゴル Mongolia		
□ B G ブルガリア Bulgaria	MW マラウィ Malawi		
□ BR ブラジル Brazil	□ M X メキシコ Mexico		
□ BY ベラルーシ Belarus	□NO ノルウェー Norway		
□ CA カナダ Canada	□ N Z ニュー・ジーランド New Zealand		
□ C H and L I スイス及びリヒテンシュタイン	□ P L ポーランド Poland		
Switzerland and Liechtenstein	□PT ポルトカル Portugal		
図CN 中国 China	□RO ルーマニア Romania		
□ C Z チェッコ Czech Republic	■ RU ロシア連邦 Russian Federation		
DE ドイツ Germany	□SD スーダン Sudan		
□ DK デンマーク Denmark	□SE スウェーデン Sweden		
□ E E エストニア Estonia	図SG シンガポール Singapore		
□ES スペイン Spain	SI スロベニア Slovenia		
FI フィンランド Finland	SK スロヴァキア Slovakia		
□GB 英国 United Kingdom	□TJ タジキスタン Tajikistan		
□GE グルジア Georgia	□ TM トルクメニスタン Turkmenistan		
□HU ハンガリー Hungary	□ TR トルコ Turkey		
□ IS アイスランド Iceland	□ T T トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago		
□JP 日本 Japan	UA ウクライナ Ukraine		
□ K E ケニア Kenya			
□ K G キルギスタン Kyrgyzstan	□UG ウガンダ Uganda		
	☑US 米国 United States of America		
KR 韓国 Republic of Korea	□UZ ウズベキスタン Uzbekistan		
K Z カザフスタン Kazakhstan	□VN ヴィエトナム Viet Nam		
LC セントルシア Saint Lucia	以下の□は、この様式の施行後に特許協力条約の締約国となった国を指定		
LK スリ・ランカ Sri Lanka	(国内特許のために) するためのものである		
LR リベリア Liberia			
LS レソト Lesotho			
LT リトアニア Lithuania			
LU ルクセンブルグ Luxembourg			
出願人は、上記の指定に加えて、規則4.9 (b)の規程に基づき、特	許協力条約の下で認められる全ての国の指定を行う。		
ただし、	の国の指定を除く。		
出願人は、これらの追加される指定が確認を条件としていること、並びに	優先日から15月が経過する前にその確認がなされない指定は、この期間		
の経過時に、出願人によって取り下げられたものとみなされることを宣言する。 <i>(指定の確認は、指定を特定する通知の提出と指定手数料及び確認 手数料の納付からなる。この確認は、優先日から15月以内に受理官庁へ提出されなければならない。)</i>			
子政科の新りからなる。この確認は、優先日から15月以内に受理官庁へ 様式PCT/RO/101 (第2用紙) (1997年1月)	が年日さればければならない。)		
-,, (N2-/1/1884) (IOU/71/17/1			

THIS PAGE BLANK

英双想 原生长之 理	4	頁		
第 VI 欄 優先権主張 下記の先の出願に基づく優先権を主張	他の優先権の主張(先	の出願)が追記欄に記載されている		
国名 (その国において又はその国について先の出版がされた)	先の出願の出願日 <i>(日. 月. 年)</i>	先の出願の出願番号	先の出願がを受理した官庁名 (広域出願又は国際出 願の場合のみ記入)	
(1) 日本国 Japan	15. 04. 97	平成9年特許願 第97780号	MR MAID VALV	
(2)				
(3)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
は、次の日にレロを行すこと。 図上記()の番号の先の出願のう 作成し国際事務局へ送付すること	<i>出願の受理官庁(日本特許庁)で発行</i> ち、次の()の番号のものについて を、受理官庁(日本特許庁の長官)に	される場合であって、優先権書類送付請ごは、出願書類の認証謄本を 対して請求している。: (1)	求書を本件国際出願に添付すると	
第 VII 欄 国際調査機関	·			
国際調査機関(ISA)の 先の調査 上記国際調査機関に 原調査の基礎とすることを請求する 当該先の調査又は請求を特定する。 国名(又は広域官庁)	よる別の調査(国際・国際型又はその 場合に記入する。先の調査に関連する	ISA/ <u>JP</u> (他) が既に実施又は請求されており、可 (5出願(若しくはその翻訳)又は関連する 出願番号	能な限り当該調査の結果を今回の[3調査請求を表示することにより、	
第 VIII 欄 照合欄				
この国際出願の用紙の枚数は次のとお	りである。 この国際出願には、以下	にチェックした書類が添付されている。		
 額書 明細書 	4 枚 1. 図別個の記名押印さ 17 枚 2. 回包括委任状の写し		ー 相当する特許印紙を貼付した書面	
3. 請求の範囲 ・・・・・	3. □記名押印 (署名) 4 枚 4 □ 原生生素類 (上記	の説明書 国際事務局の口座	への振込みを証明する書面	
4. 要約書 ・・・・・・	4. □優先権書類 <i>(上記</i> 1 枚			
5. 図面 ・・・・・・・	9 枚	(フレキシブルディ		
	5 枚	8. 図その他 (例えば、 記載する 優先権書類送付請		
要約書とともに公表する図として <u>第</u>)		
第 IX 欄 提出者の記名押目	Į į			
各人の氏名(名称)を記載し、その次に 鈴 木 喜三郎 名	に押印する。			
鈴木 喜三郎 上 柳 雅 誉 須 澤 修	是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一		:1%	
1. 国際出願として提出された書類の第	受理官庁記入	欄	2. 図面	
3. 国際出願として提出された書類を補	完する書類又は図面であって		受理された	
			不足図面がある	
4. 特許協力条約第11条(2)に基づく	必要な補完の期間内の受理の日			
5. 出願人により特定された IS 国際調査機関		査手数料未払いにつき、国際調査機関に 査用写しを送付していない	:	
国際事務局記入欄				
高級原本の受理の日:				

THIS PAGE BLANK (USE)